

PACS numbers: 41.20.Cv, 42.25.-p, 73.20.Mf, 73.21.Ac, 73.22.Lp, 78.67.Bf, 78.67.Pt

## **Виникнення додаткових плазмових резонансів у шаруватих малих частинках**

Л. Б. Лерман

*Інститут хімії поверхні НАН України,  
вул. Генерала Наумова, 17,  
03164 Київ, Україна*

В довгохвильовому наближенні розглянуто задачу виникнення додаткових поверхневих плазмонних резонансів у шаруватих наночастинках еліпсоїдної та кулястої форми під дією електромагнетного випромінення. Детально досліджено випадки двошарових частинок з металевим ядром та металевою оболонкою. Для кулястої частинки із срібним ядром і золотою оболонкою досліджено вплив об'ємної частини ядра на спектри вбирання електромагнетного випромінення в оптичному діапазоні.

Within the long-wave approach, the problem of occurrence of additional surface plasmon resonances in layered nanoparticles of the ellipsoidal and spherical shape under electromagnetic irradiation is considered. The cases of two-layer particles with a metal kernel and a metal shell are thoroughly investigated. In an optical range, the influence of kernel bulk fraction on the absorption spectra of electromagnetic radiation is investigated for a spherical particle with a silver kernel and gold shell.

В длинноволновом приближении рассмотрена задача возникновения дополнительных поверхностных плазмонных резонансов в слоистых наночастицах эллипсоидальной и сферической формы под действием электромагнитного излучения. Подробно исследованы случаи двухслойных частиц с металлическим ядром и металлической оболочкой. Для сферической частицы с серебряным ядром и золотой оболочкой исследовано влияние объемной доли ядра на спектры поглощения электромагнитного излучения в оптическом диапазоне.

**Ключові слова:** електростатика, плазмонні резонанси, еліпсоїдні наночастинки, шарові наночастинки.

*(Отримано 23 листопада 2008 р.)*

## 1. ВСТУП

Визначення поляризованості частинок шаруватої будови дозволяє теоретично досліджувати взаємодію електромагнетних хвиль з такими частинками і визначати потрібні характеристики розсіяння і вбирання. Розв'язання цієї задачі складається з розгляду деякої задачі електростатики [1]. Гладкою частинкою найбільш загального вигляду — без ребер і зломів є еліпсоїд з довільними значеннями півосей, що дозволяє в рамках єдиного моделю описувати і кулі, і пласкі, і лійні частинки. Ця задача розглядалася багатьма авторами, і замкнені формули для обчислення поляризованості суцільного еліпсоїда і еліпсоїда з покриттям (двошаровий еліпсоїд) добре відомі [1], але задача для багатошарового еліпсоїда значно ускладнюється. В [2–6] було запропоновано один з можливих підходів до визначення поляризованості еліпсоїдних частинок з довільним числом шарів, а зокрема кулі [3, 6] з діелектрично анізотропними шарами із застосуванням так званих трансляційних матриць, які дозволяють переносити граничні умови з шару на шар. В роботі [4] досягнуто добре узгодження розрахункових спектрів ослаблення світла у водяних суспензіях наночастинок срібла з оболонкою з оксиду срібла з даними експериментальних досліджень.

В цій роботі на основі загальних співвідношень, одержаних раніш [2–6], докладно розглянуто випадок двошарових частинок з металевим ядром та металевою оболонкою, так звані біметалеві частинки. Проаналізовано можливість виникнення додаткових поверхневих плазмонів. Для шаруватої частинки із срібним ядром і золотою оболонкою досліджено вплив об'ємної частини ядра на спектри вбирання електромагнетного випромінення в оптичному діапазоні.

## 2. ОСНОВНІ РОЗРАХУНКОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ

Повний розв'язок задачі електростатики для еліпсоїдних і сферичних шаруватих частинок із застосуванням трансляційних матриць було одержано раніш в роботах [2, 5, 6]. Наведемо основні результати цих досліджень. Отже, розглянемо багатошарову частинку, яка складається із довільного числа конфокальних еліпсоїдів (рис. 1) з комплексними діелектричними проникностями шарів  $\epsilon_j$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ ). Головні півосі еліпсоїдів позначимо через  $a_j, b_j, c_j$ . Вважається, що еліпсоїд знаходиться в зовнішньому електростатичному полі з напруженістю  $\mathbf{E}_0$ .

Згідно з [1], розв'язки будуються окремо для випадків, коли напрямок вектора напруженості співпадає з напрямками головних осей еліпсоїда  $x, y, z$ . Тоді, наприклад, поляризованість  $\alpha_z$  шаруватого еліпсоїда у напрямі прикладеного зовнішнього поля, що діє у напрямі однієї з головних осей еліпсоїда (індекси 1, 2, 3), визначається за формулою [5]:

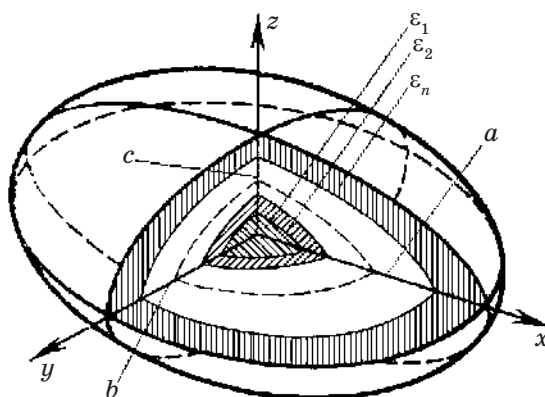


Рис. 1. Багатошарова частинка у вигляді конфокальних еліпсоїдів.

$$\alpha_3 = \frac{4\pi a_n b_n c_n}{3} \frac{(\varepsilon_n - \varepsilon_m)(a_n b_n c_n)t_{11} + 2(\varepsilon_n - \varepsilon_m)(L_3^{(n)} - \varepsilon_n)t_{21}}{[(\varepsilon_n - \varepsilon_m)L_3^{(n)} + \varepsilon_m](a_n b_n c_n)t_{11} + 2(\varepsilon_n - \varepsilon_m)L_3^{(n)}(L_3^{(n)} - 1)t_{21}}, \quad (1)$$

де  $t_{11}$ ,  $t_{21}$  — елементи трансляційної матриці  $T_n(\xi_n, \xi_1)$  при переході від 1-го до  $n$ -го шару ( $r_j$  — координати границь поділу еліпсоїдів вздовж осі  $z$ ). Трансляційна матриця визначається виразом

$$T_n(\xi_n, \xi_1) = \prod_{j=1}^{n-1} T_{n-j}. \quad (2)$$

При цьому матриці  $T_j$  при переході  $j$ -ої межі поділу визначаються співвідношенням

$$T_j = \begin{bmatrix} 1 + L_3^{(j)} \left( \frac{\varepsilon_j}{\varepsilon_{j+1}} - 1 \right) & L_3^{(j)} (1 - L_3^{(j)}) \left( 1 - \frac{\varepsilon_j}{\varepsilon_{j+1}} \right) \\ \frac{v_j}{v_{j+1}} \left( 1 - \frac{\varepsilon_j}{\varepsilon_{j+1}} \right) & \frac{v_j}{v_{j+1}} \left[ 1 + L_3^{(j)} \left( 1 - \frac{\varepsilon_j}{\varepsilon_{j+1}} \right) \right] \end{bmatrix}, \quad (3)$$

де використано геометричні фактори (фактори деполаризації) еліпсоїдів [1]

$$L_3^{(j)} = \frac{a_j b_j c_j}{2} \int_0^\infty \frac{dq}{(c_j^2 + q)f_j(q)}, \quad f_j(q) = \sqrt{(a_j^2 + q)(b_j^2 + q)(c_j^2 + q)}. \quad (4)$$

Якщо  $n = 1$ , то формула (1) переходить у відому формулу для поляризованості суцільного еліпсоїда [1], а для двошарового еліпсоїда (еліпсоїда в оболонці) слід прийняти  $n = 2$ , і після деяких перетворень матимемо:

$$\alpha_3 = V \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_m)[\varepsilon_2 + (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(L_3^{(1)} - vL_3^{(2)})] + v\varepsilon_2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{[\varepsilon_2 + (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(L_3^{(1)} - vL_3^{(1)})][\varepsilon_m + (\varepsilon_2 - \varepsilon_m)L_3^{(2)}] + vL_3^{(2)}\varepsilon_2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}, \quad (5)$$

де  $V$  — об'єм еліпсоїда;  $v$  — частина повного об'єму, який займає внутрішній еліпсоїд (ядро частинки). Формула (5) збігається з результатами, наведеними в [1].

Аналогічні вирази матимуть місце і для поляризованості  $\alpha_1$  і  $\alpha_2$  в напрямках  $x, y$  інших головних осей відповідно. Для цього досить замінити індекси у всіх розрахункових формулах для геометричних факторів, тобто замість  $L_3^{(j)}$  використовувати формули

$$L_1^{(j)} = \frac{a_j b_j c_j}{2} \int_0^\infty \frac{dq}{(a_j^2 + q)f_j(q)} \quad \text{і} \quad L_2^{(j)} = \frac{a_j b_j c_j}{2} \int_0^\infty \frac{dq}{(b_j^2 + q)f_j(q)}. \quad (6)$$

Зауважимо, що завжди  $L_1^{(j)} + L_2^{(j)} + L_3^{(j)} = 1$  і  $L_k^{(j)} < 1$ . Із загальних формул для еліпсоїда можна одержати розрахункові формули для багатосарової кулі, якщо покласти  $L_1^{(j)} = L_2^{(j)} = L_3^{(j)} = 1/3$ , але зручніше використовувати безпосередньо розв'язок задачі електростатики для багатосарової кулі [6].

При вивченні світлорозсіяння на малих металевих частинках треба враховувати, що діелектричні проникності шарів залежать від частоти щ (довжини хвилі  $\lambda$ ), тобто  $\varepsilon_j = \varepsilon_j(\lambda) = \varepsilon_j(\omega)$ . Тоді корені рівняння

$$\Delta_f = \{[(\varepsilon_n - \varepsilon_m)L_3^{(n)} + \varepsilon_m](a_n b_n c_n)t_{11} + 2(\varepsilon_n - \varepsilon_m)L_3^{(n)}(L_3^{(n)} - 1)t_{21}\} = 0 \quad (10)$$

будуть визначати частоти поверхневих мод, тобто максимуми вбирання і світлорозсіяння. Для еліпсоїда загального вигляду в оболонці після підставлення елементів трансляційної матриці для двосарового еліпсоїда будемо мати три незалежних рівняння вигляду

$$\begin{aligned} & [\varepsilon_2 + (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(L_k^{(1)} - vL_k^{(2)})] \times \\ & \times [\varepsilon_m + (\varepsilon_2 - \varepsilon_m)L_k^{(2)}] + vL_k^{(2)}\varepsilon_2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) = 0 \quad (k = 1, 2, 3). \end{aligned} \quad (11)$$

Для кулястої частинки в оболонці всі три рівняння (11) співпадають і приймають більш простий вигляд

$$(\varepsilon_2 + 2\varepsilon_m)(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2) + 2v(\varepsilon_2 - \varepsilon_m)(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) = 0. \quad (12)$$

Отже задача полягає в знаходженні дійсних коренів нелінійних рівнянь з комплексними коефіцієнтами. Аналітичне дослідження цих рівнянь практично неможливе за випадком суцільного еліпсоїда, яке виконано в [5], та еліпсоїда в оболонці; тому його доводиться розв'язувати чисельно.

В цій роботі ми детально дослідимо останній випадок.

### 3. ПОВЕРХНЕВІ ПЛАЗМОНИ В ЕЛІПСОЇДІ І КУЛІ З ОБОЛОНКОЮ

Запишемо рівняння (11) у вигляді квадратного рівняння відносно діелектричної проникності оболонки  $\varepsilon_2$ :

$$\varepsilon_2^2 + 2p_k\varepsilon_2 + q_k = 0 \quad (k = 1, 2, 3), \quad (13)$$

де коефіцієнти рівняння  $p_k, q_k$  визначаються за формулами

$$p_k = \frac{\beta_k(\alpha_k + \nu)\varepsilon_1 + (1 - \alpha_k)(1 - \beta_k)\varepsilon_m}{2\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)}, \quad q_k = \frac{\alpha_k(1 - \beta_k)}{\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)}\varepsilon_1\varepsilon_m, \quad (14)$$

і для скорочення запису введено параметри  $\alpha_k = L_k^{(1)} - \nu L_k^{(2)}$ ,  $\beta_k = L_k^{(2)}$ .

Корені рівняння (13)  $\zeta_1, \zeta_2$  визначаються формулами:

$$\zeta_{1,2}^{(k)} = -p_k \pm \sqrt{p_k^2 - q_k}. \quad (15)$$

У випадку двошарової кулі (рівняння (12)) вирази (14) спрощуються і набувають вигляд:

$$p_k = p = \frac{(1 + 2\nu)\varepsilon_1 + 2(2 + \nu)\varepsilon_m}{4(1 - \nu)}, \quad q_k = q = \varepsilon_1\varepsilon_m, \quad (16)$$

а для визначення коренів лишається вираз (11).

Можливі три випадки будови частинок з оболонкою. В першому випадку маємо металеве ядро і діелектричну оболонку. Прямі розрахунки оптичних спектрів таких частинок, наприклад, для наночастинок срібла з оболонкою з оксиду срібла [4, 7] показують, що при цьому виникає лише одна плазмова частота за рахунок металевого ядра. Вплив діелектричної оболонки виявляється у зсуві плазмонної частоти, і цей зсув залежить від товщини оболонки.

В другому випадку для діелектричного ядра і металеві оболонки в спектрах спостерігається два максимуми вбирання, наприклад, ядро з сірчаного золота або кремнію і золота оболонка [8, 9].

Нарешті, в третьому випадку і ядро і оболонка вважаються металевими (біметалеві частинки). Цей випадок останнім часом викликає велику увагу у зв'язку з розробленням технології створення наночастинок із золотим ядром і срібною оболонкою.

Дослідження показують, що в останніх двох випадках виникають дві плазмонні частоти. Розглянемо докладніше біметалеву частинку.

В цьому випадку матимемо рівняння (13) другого степеня відносно  $\varepsilon_2$  з комплексними коефіцієнтами. Для аналізу рівняння покладемо:

$$\varepsilon_1 = \varepsilon'_1 + i\varepsilon''_1, \quad \varepsilon_2 = \varepsilon'_2 + i\varepsilon''_2, \quad p_k = p'_k + ip''_k, \quad q_k = q'_k + iq''_k,$$

де у випадку еліпсоїда

$$p'_k = \frac{\beta_k(\alpha_k + \nu)}{2\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)} \varepsilon'_1 + \frac{(1 - \alpha_k)(1 - \beta_k)}{2\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)} \varepsilon_m, \quad p''_k = \frac{\beta_k(\alpha_k + \nu)}{2\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)} \varepsilon''_1, \quad (17)$$

$$q'_k = \frac{\alpha_k(1 - \beta_k)}{\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)} \varepsilon_m \varepsilon'_1, \quad q''_k = \frac{\alpha_k(1 - \beta_k)}{\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)} \varepsilon_m \varepsilon''_1. \quad (18)$$

Підставляємо ці вирази до рівняння (13) і, відокремлюючи дійсну та уявну частини, одержуємо наступну систему рівнянь ( $k = 1, 2, 3$ ):

$$(\varepsilon'_2)^2 + 2p'_k \varepsilon'_2 + q'_k - \varepsilon''_2(1 + 2p''_k \varepsilon''_2) = 0, \quad 2\varepsilon'_2 \varepsilon''_2 + 2(p''_k \varepsilon'_2 + p'_k \varepsilon''_2) = 0. \quad (19)$$

Якщо знехтувати втратами, то друге рівняння задовольняється тотожно, а перше набуває вигляд

$$(\varepsilon'_2)^2 + 2p'_k \varepsilon'_2 + q'_k = 0. \quad (20)$$

Формально рівняння (20) не відрізняється від рівняння для випадку, коли ядро — це ідеальний діелектрик, а оболонка — метал. Суттєва відміна полягає в тому, що цього разу коефіцієнти рівняння залежать від частоти, тобто  $p'_k = p'_k(\omega)$ ,  $q'_k = q'_k(\omega)$ , і це суттєво ускладнює його аналіз. Для скорочення запису введемо додаткові позначення:

$$p'_k = c_1 \varepsilon'_1 + c_2 \varepsilon_m, \quad p''_k = c_3 \varepsilon''_1, \quad q'_k = c_4 \varepsilon'_1, \quad q''_k = c_4 \varepsilon''_1, \quad (21)$$

де

$$c_1 = \frac{\beta_k(\alpha_k + \nu)}{2\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)}, \quad c_2 = \frac{(1 - \alpha_k)(1 - \beta_k)}{2\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)},$$

$$c_3 = \frac{\beta_k(\alpha_k + \nu)}{2\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)} \sqrt{a^2 + b^2}, \quad c_4 = \frac{\alpha_k(1 - \beta_k)}{\beta_k(1 - \alpha_k - \nu)} \varepsilon_m.$$

Прийmemo, що діелектрична проникність обох металів описується моделлю Друде:

$$\varepsilon_j(\omega) = \varepsilon_{j,\infty} - \frac{\omega_{pj}^2}{\omega(\omega + i\gamma_j)} = \varepsilon_{j,\infty} - \frac{\omega_{pj}^2}{\omega^2 + \gamma_j^2} + i \frac{\omega_{pj}^2 \gamma_j}{\omega(\omega^2 + \gamma_j^2)} \quad (j = 1, 2), \quad (22)$$

де  $\omega = 2\pi c / \lambda$  — частота;  $c$  — швидкість світла;  $\varepsilon_{j,\infty}$  — граничні значення діелектричної проникності, коли  $\omega \rightarrow \infty$ ,  $\omega_{pj}$  — плазмонні частоти;  $\gamma_j$  — частоти вбирання.

Тоді для дійсних частин діелектричних функцій ядра і оболонки при  $\gamma_1 \rightarrow 0$ ,  $\gamma_2 \rightarrow 0$  будемо мати:

$$\varepsilon_1'(\omega) \approx \varepsilon_{1,\infty} - \omega_{p1}^2 / \omega^2, \quad \varepsilon_2'(\omega) \approx \varepsilon_{2,\infty} - \omega_{p2}^2 / \omega^2. \quad (23)$$

Введемо нову змінну  $z = \varepsilon_{2,\infty} - \omega_{p2}^2 / \omega^2$  і позначимо відношення плазмових частот через  $\xi = \omega_{p1}^2 / \omega_{p2}^2$ . Тоді квадратне рівняння для визначення нової невідомої при  $\varepsilon_1'(\omega) = \varepsilon_{1,\infty} - \xi(\varepsilon_{2,\infty} + z)$  набуває вигляду

$$\begin{aligned} & \left( 1 + 2c_1 \frac{\omega_{p1}^2}{\omega_{p2}^2} \right) z^2 + 2 \left[ c_1 \left( \varepsilon_{1,\infty} - \frac{\omega_{p1}^2}{\omega_{p2}^2} \varepsilon_{2,\infty} \right) + c_2 \varepsilon_m + \frac{1}{2} \frac{\omega_{p1}^2}{\omega_{p2}^2} c_4 \right] z + \\ & + \left( \varepsilon_{1,\infty} - \frac{\omega_{p1}^2}{\omega_{p2}^2} \varepsilon_{2,\infty} \right) c_4 = 0. \end{aligned} \quad (24)$$

Позначимо корені рівняння (24) через  $z_{1,2}$ . Тоді для існування резонансних частот вони повинні бути дійсними і задовольняти нерівності  $z_{1,2} < \varepsilon_{2,\infty}$ . Самі резонансні частоти при цьому визначаються за формулами

$$\omega_{r1}^{(k)} = \omega_{p2} / \sqrt{\varepsilon_{2,\infty} - z_1^{(k)}}, \quad \omega_{r2}^{(k)} = \omega_{p2} / \sqrt{\varepsilon_{2,\infty} - z_2^{(k)}} \quad (k = 1, 2, 3). \quad (25)$$

Для кулі будемо мати:

$$c_1 = \frac{1 + 2\nu}{4(1 - \nu)}, \quad c_2 = \frac{2 + \nu}{2(1 - \nu)}, \quad c_4 = \varepsilon_m,$$

і рівняння (24) набуває вигляду:

$$\begin{aligned} & \left( 1 + \frac{1 + 2\nu}{2(1 - \nu)} \frac{\omega_{p1}^2}{\omega_{p2}^2} \right) z^2 + \\ & 2 \left[ \frac{1 + 2\nu}{4(1 - \nu)} \left( \varepsilon_{1,\infty} - \frac{\omega_{p1}^2}{\omega_{p2}^2} \varepsilon_{2,\infty} \right) + \frac{2 + \nu}{2(1 - \nu)} \varepsilon_m + \frac{\omega_{p1}^2}{2\omega_{p2}^2} \varepsilon_m \right] z + \\ & + \left( \varepsilon_{1,\infty} - \frac{\omega_{p1}^2}{\omega_{p2}^2} \varepsilon_{2,\infty} \right) \varepsilon_m = 0. \end{aligned} \quad (26)$$

Коефіцієнти, а тому і розв'язки рівняння (26), залежать від об'ємної частини ядра  $\nu$  і параметрів  $\varepsilon_{1,\infty}$ ,  $\varepsilon_{2,\infty}$ ,  $\varepsilon_m$ ,  $\omega_{p1}$ ,  $\omega_{p2}$  матеріалів. Зауважимо, що до рівняння входить тільки відношення квадратів плазмових частот

$$f = \omega_{p1}^2 / \omega_{p2}^2.$$

В деяких випадках плазмові частоти суцільних матеріалів до-

силь близькі, і тоді відношення частот  $f \approx 1$  (наприклад, для срібла  $\omega_p^{\text{Ar}} = 1,46 \cdot 10^{16}$  1/с, для золота  $\omega_p^{\text{Au}} = 1,37 \cdot 10^{16}$  1/с), а відношення частот  $\omega_p^{\text{Ar}} / \omega_p^{\text{Au}} = 1,066$ ). Якщо прийняти додатково  $\epsilon_{1,\infty} = \epsilon_{2,\infty} = 1$ , то рівняння (25) матиме один корінь  $z \approx 0$ , який не залежить від об'ємної частини ядра в частинці. Це означає, що завжди одна з резонансних частот  $\omega_{r1} \approx \omega_{p2}$ , тобто приблизно дорівнює плазмовій частоті матеріялу оболонки. При цьому оцінку другого кореня можна знайти безпосередньо з рівняння за Вієттовою теоремою:

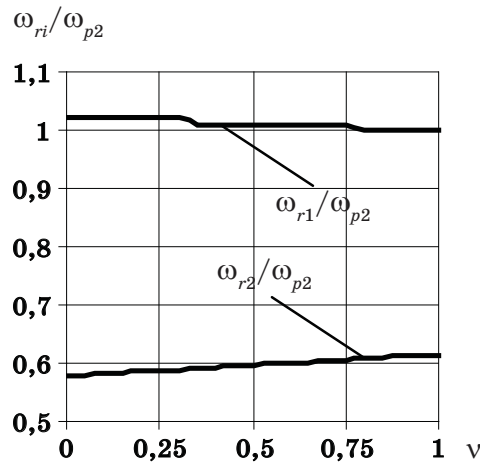
$$z_2 \approx - \frac{(1 + 2\nu)(1 - f) + 2(2 + \nu)\epsilon_m + 2f(1 - \nu)\epsilon_m}{2(1 - \nu) + (1 + 2\nu)f}, \quad (27)$$

і, отже, друга частота залежить від об'ємного наповнення.

Одержані формули проілюструємо на рис. 2 графіками залежності безрозмірних резонансних частот від об'ємного наповнення для кулі із срібним ядром і золотою оболонкою, яку розташуємо у вакуумі. При розрахунках приймалось, що  $\epsilon_{1,\infty} = \epsilon_{2,\infty} = 1$ , але враховувалась різниця між плазмонними частотами золота і срібла, тобто  $f = 1,066$ .

З наведених графіків випливає, що, дійсно, одна з резонансних частот майже не залежить від об'ємної частини ядра і співпадає з частотою плазмонної частоти оболонки (в даному випадку золота).

Зауважимо, що при граничних значеннях об'ємного наповнення (при  $\nu = 0$  або  $\nu = 1$ ) одна з цих частот не буде мати фізичного змісту.



**Рис. 2.** Залежність безрозмірних резонансних частот від об'ємної частини  $\nu$  срібного ядра для кулі з золотою оболонкою.



#### 4. ВБИРАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ МАЛОЮ БІМЕТАЛЕВОЮ ЧАСТИНКОЮ

Для малих частинок в електростатичному наближенні ефективність вбирання ЕМВ  $Q_{abc}$  визначається уявною частиною поляризованості. Наприклад, згідно з [1], для системи еліпсоїдів, що орієнтовані вздовж вісі  $z$ , характеристики світлорозсіяння можна обчислити за формулами

$$\langle Q_{abs} \rangle = \frac{k}{3\pi R^2} \text{Im } \alpha_3, \quad (28)$$

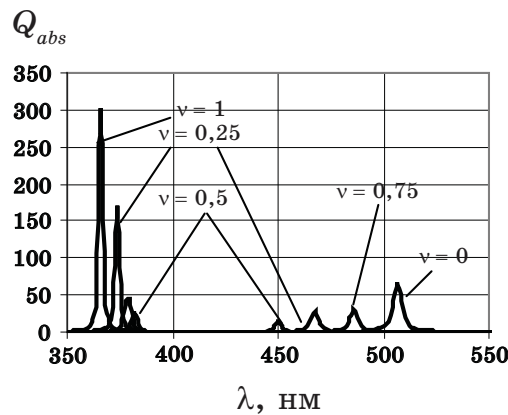
де  $k = 2\pi / \lambda$  — хвильове число;  $\lambda$  — довжина хвилі;  $R$  — радіус сфери з об'ємом, що дорівнює об'єму зовнішнього еліпсоїда.

Отже, для системи двошарових куль будемо мати формулу:

$$Q_{abs} = \frac{8\pi a}{\lambda} \text{Im } \alpha^*, \quad (29)$$

де  $\alpha^*$  обчислюється за формулою (1), у якій слід покласти  $L_1 = L_2 = L_3 = 1/3$ , а  $\alpha^* = \alpha/V$  ( $V$  — об'єм частинки).

Наведемо деякі результати розрахунків для біметалевої кулястої частинки із срібним ядром і золотою оболонкою для різних значень розмірів ядра і оболонки. Оскільки вбирання пропорційно уявній частині поляризованості частинки, то спектральні залежності вбирання і поляризованості матимуть екстремуми в тих самих точках. Тому достатньо обмежитись спектральною залежністю ефективності вбирання. Такі залежності від об'ємної частини  $v$ , яку складає срібне ядро в біметалевій частинці, показано на рис. 3. Розрахунки



**Рис. 3.** Спектри ефективності вбирання біметалевої кулястої частинки для різних значень об'ємного співвідношення срібного ядра і золотої оболонки.

виконані для частинки із зовнішнім радіусом 10 нм, який зберігався сталим, а змінювався тільки розмір ядра. Для опису діелектричних функцій ядра і оболонки використано модель Друде із параметрами, вказаними вище, але в розрахунках прийнято, що  $\epsilon_{1,\infty} = 4,5$ ,  $\epsilon_{2,\infty} = 10$ . Вважалося, що частинки розташовані у воді ( $\epsilon_m = 1,77$ ).

Ці результати підтверджують теоретичні міркування, викладені в розділі 3. З графіків випливає, що початкова довжина хвилі поверхневого плазмону срібного ядра  $\lambda_{1p} = 366$  нм із збільшенням розмірів оболонки розщеплюється на дві і прямує до довжини хвилі поверхневого плазмону суцільної золотої частинки  $\lambda_{2p} = 506$  нм.

## 6. ВИСНОВКИ

На підставі проведеного аналітичного дослідження рівняння для визначення резонансних частот еліпсоїдної частинки (в окремому випадку кулі) з оболонкою встановлено, що у частинках з металевим ядром і металевою оболонкою виникають дві резонансні частоти. При цьому якщо плазмонні частоти для суцільних матеріалів близькі між собою, одна з частот поверхневих плазмонів двошарової частинки приблизно збігається з плазмонною частотою матеріалу оболонки.

Результати аналізу підтверджені розрахунками спектрів вибрання в таких частинках. Отже, виникає можливість керування зсувом частот поверхневих плазмонів у потрібному напрямку.

Роботу виконано при частковому фінансуванні договору № 28 в рамках спільного проекту НАН України и Фонду фундаментальних досліджень РАН.

Автор висловлює щире подяку професору Л. Г. Гречку за цінні поради, висловлені в процесі роботи над статтею та обговоренні одержаних результатів.

## ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. К. Борен, Д. Хафмен, *Поглощение и рассеяние света маленькими частицами* (Москва: Мир: 1986).
2. Л. Г. Гречко, Л. Б. Лерман, Н. Г. Шкода, *Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат.*, № 1: 386 (2004).
3. Л. Г. Гречко, Л. Б. Лерман, Н. Г. Шкода, *Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат.*, № 3: 376 (2004).
4. Л. Г. Гречко, А. М. Єременко, Г. В. Крилова, Л. Б. Лерман, Н. П. Смірнова, Н. Г. Шкода, *Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат.*, № 4: 450 (2004).
5. Л. Г. Гречко, Л. Б. Лерман, Л. М. Білокриницька, С. В. Шостак, *Вісник Ки-*

- ївського університету. Сер. фіз.-мат., № 4: 416 (2006).*
6. Л. Г. Гречко, Л. Б. Лерман, Д. Л. Водоп'янов, С. В. Шостак, *Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат., № 1: 416 (2007).*
  7. K. Chatterjee, S. Banerjee, and D. Chakravorty, *Phys. Rev. B*, **66**: 085421-1 (2002).
  8. R. D. Averitt, D. Sarkar, and N. J. Halas, *Phys. Rev. Lett.*, **78**, No. 22: 4217 (1997).
  9. P. K. Jain, I. H. El-Sayed, and M. A. El. Sayed, *Nanotoday*, **2**, No. 1: 18 (2007).